

隔离型、原边控制恒流模式 LED 功率开关

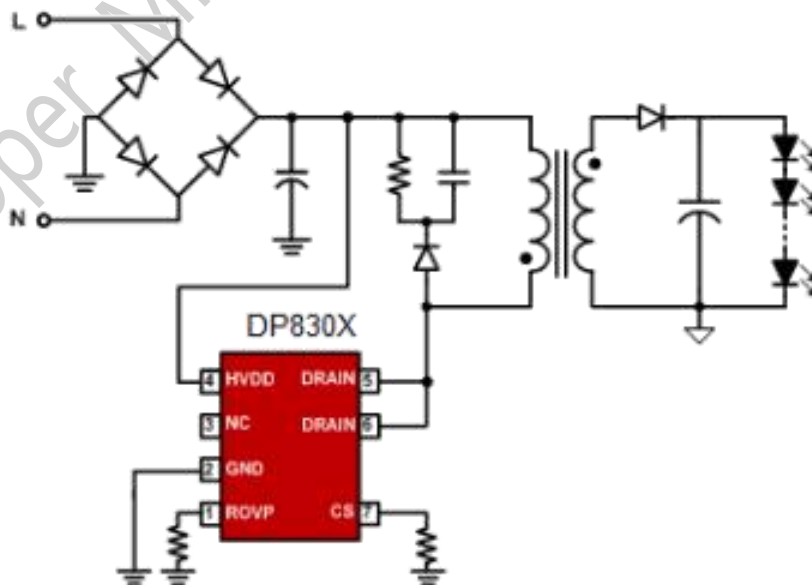
主要特点

- 集成高压 650VMOSFET
- 集成高压自供电电路
- 无 VDD 电容设计
- 原边反馈恒流控制
- $\pm 5\%$ 恒流精度
- 超低工作电流
- 优异的线电压和负载调整率
- 内部保护功能：
 - 输出过压保护(OVP)
 - 逐周期电流限制(OCP)
 - 前沿消隐(LEB)
 - LED 开路 and 短路保护
 - 过热保护 (OTP)
- 封装类型 SOP-7, DIP-7

典型应用

- LED 筒灯、LED 吸顶灯、LED 面板灯
- 其他大功率 LED 照明

典型应用电路



产品描述

DP830X 系列是高度集成的原边控制、恒流模式 LED 功率开关，芯片工作在电感电流断续模式，适用于隔离反激型 LED 恒流电源。

DP830X 内部集成 650V 功率 MOSFET 和高压自供电电路，采用专利的消磁检测技术，无需辅助绕组检测消磁和供电，简化了系统的设计和生产成本。芯片集成高精度的电感电流采样电路，可以获得高精度的恒流输出和优异的线电压和负载调整率。

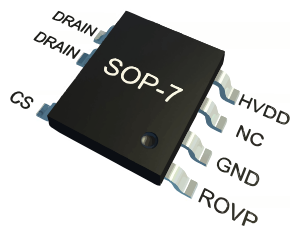
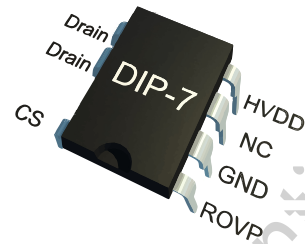
DP830X 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行，如：VDD 欠压保护功能 (UVLO)、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、LED 开路 and 短路保护等。

封装信息

型号	描述
DP830X	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
	DIP-7, 无铅, 50 颗/管

产品说明

➤ 管脚封装


SOP-7

DIP-7

➤ 管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	ROVP	I	接电阻到地，调节输出过压保护电压，推荐使用 5K~14K 电阻连接到 GND。具备 ROVP 开路保护功能，悬空时，等效于 ROVP=14K。ROVP 脚同时集成有使能功能，接地时关闭系统。
2	GND	P	芯片的参考地
3	NC	---	非功能管脚，使用中悬空
4	HVDD	P	芯片高压供电管脚
5,6	Drain	P	内部功率 MOSFET 漏极输入管脚
7	CS	O	内部功率 MOSFET 源极输出管脚以及采样输入管脚

➤ 产品标记



DP830X 为产品品名：

XXXXXX 第一个 X 代表年份最后一位，例 2014 即 4；第二个 X 代表月份，用 A-L 12 个字母表示；第四个 X 代表日，01-31 表示；最后两个 X 代表晶圆批号代码

➤ 输出功率表

产品型号	封装	最大输出功率		最低输出反射电压 Nps*Vo
		85-265V 输入	175-265V 输入	
DP8301	SOP-7	3W	5W	30V
DP8302	SOP-7	5W	8W	
DP8303A	SOP7	7W	10W	
DP8303	SOP-7	12W	18W	
DP8304	DIP-7	18W	24W	
DP8305	DIP-7	24W	30W	

➤ 极限参数 (1)

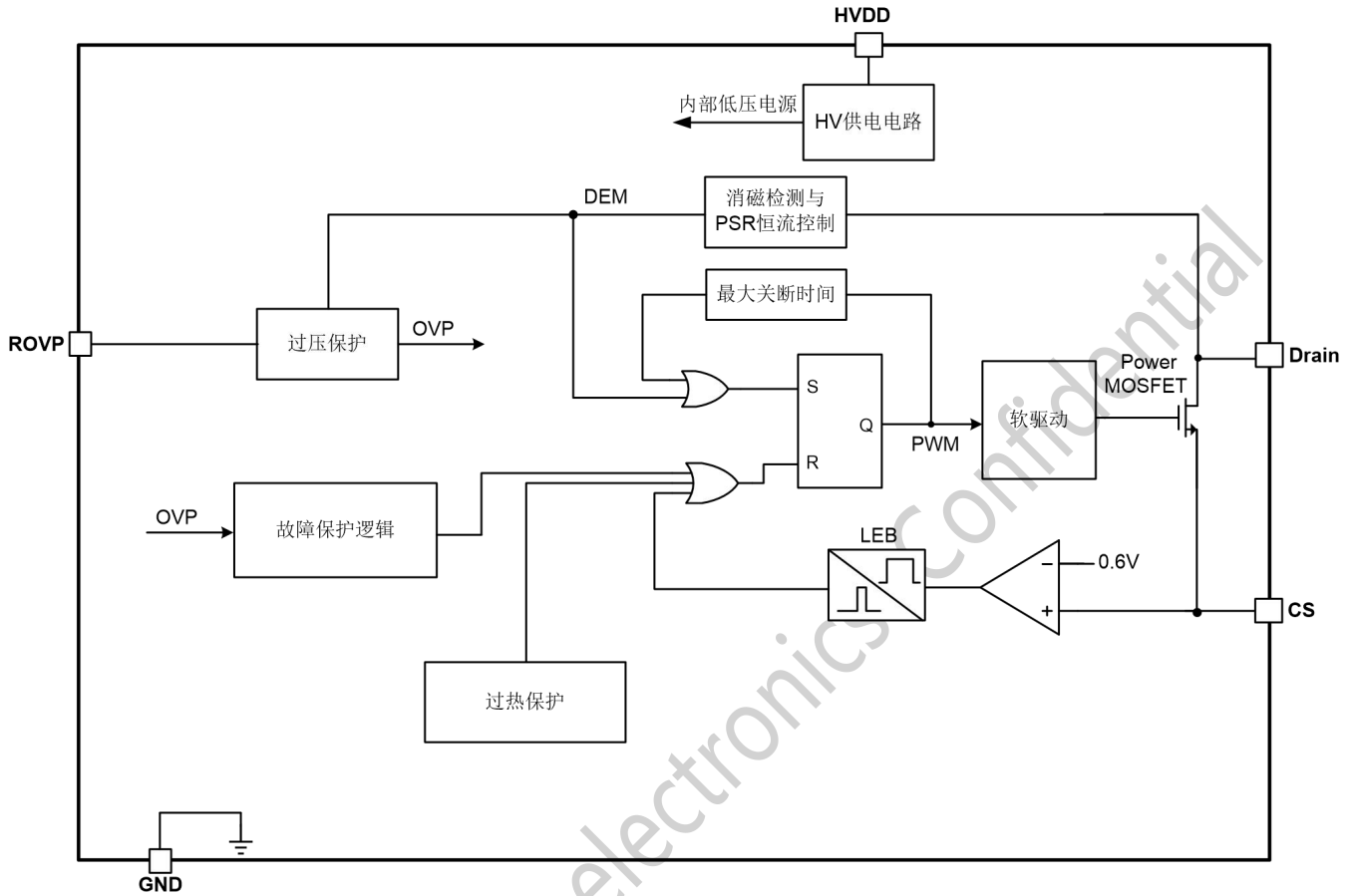
参数	数值	单位
Drain, HVDD 电压	-0.3 to 650	V
CS、ROVP 电压	-0.3 to 7	V
P _{Dmax} , 耗散功率@T _A =50°C(SOP-7) (2)	0.6	W
Θ _{JA} 封装热阻---结到环境(SOP-7)	165	°C/W
P _{Dmax} , 耗散功率@T _A =50°C(DIP-7) (2)	0.9	W
Θ _{JA} 封装热阻---结到环境(DIP-7)	105	°C/W
芯片工作结温	150	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV

备注1: 超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注2: 最大耗散功率 $P_{Dmax} = (T_{Jmax} - T_A) / \Theta_{JA}$ ，环境温度升高时最大耗散功率会随之降低。

备注3: 最大输出功率受限于芯片最高结温，且与环境温度和 PCB 有关，实际系统最大输出功率请以测试为准。

内部功能框图



推荐工作条件

参数	数值	单位
工作结温	-40 to 125	°C

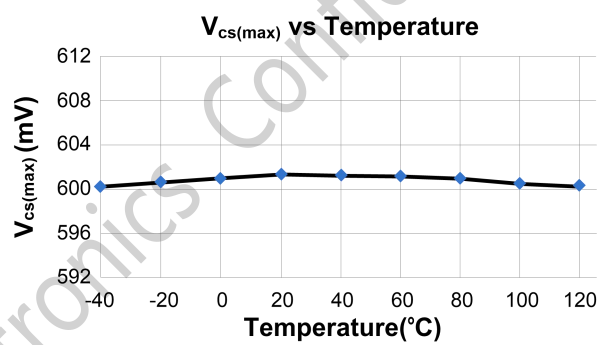
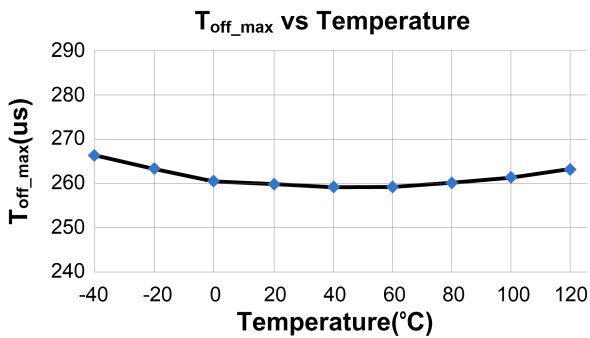
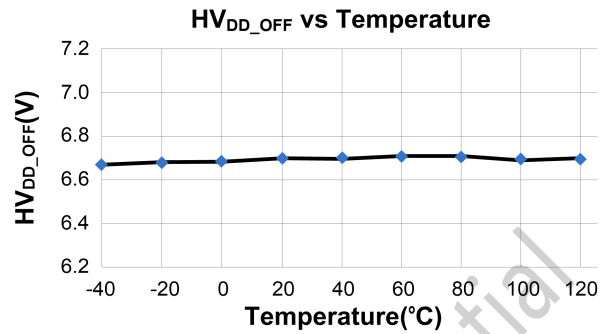
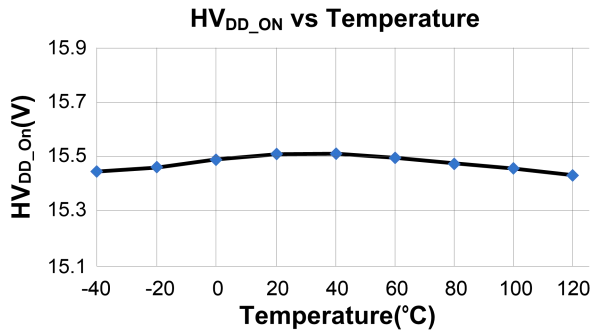
电气参数 (环境温度为 25 °C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分(HVDD 管脚)						
I_{VDD_st}	启动电流	$V_{DD} < V_{DD_op}$		5400		uA
I_{VDD_Op}	工作电流	$F_{sw} = 7KHz$	80	150	300	uA
HV_{DD_ON}	HVDD 脚启动电压			15.5		V
HV_{DD_OFF}	HVDD 脚关断电压		5.8	6.6	7.5	V
T_{off_min}	最短关断时间	(备注 4)		3		us
T_{on_max}	最长导通时间	(备注 4)		35		us
T_{off_max}	最长关断时间		195	270	350	us
F_{max}	最高开关频率		100	125	150	KHz
电流采样部分 (CS 管脚)						
T_{LEB}	电流采样前沿消隐时间		300	500	700	ns
$V_{cs(max)}$	峰值电流基准		590	600	610	mV
T_{D_OC}	关断延时			100		ns
输出过压保护部分 (ROVP 管脚)						
I_{ROVP}	ROVP 输出电流		36	40	44	uA
使能部分 (ROVP 管脚)						
V_{ROVP}	ROVP 电压	当 $V_{ROVP} < 50mV$ 时, 芯片停止工作		50		mV
过热保护部分						
T_{SD}	智能温度调节阈值	(备注 4)		145		°C
高压启动和 IC 供电部分 (Drain管脚)						

I_{HV}	HV 充电电流	Drain =20V		10		mA
I_{HV_leak}	HV 漏电流		10	40	60	uA
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		V			
R_{dson}	导通阻抗	DP8301	650	24		Ω
		DP8302	650	13.2		Ω
		DP8303A	600	7.5		Ω
		DP8303	600	3.6		Ω
		DP8304	600	3.6		Ω
		DP8305	600	2		Ω

备注4: 参数取决于实际设计, 在批量生产时进行功能性测试。

参数特性曲线



功能描述

DP830X 系列是高度集成的原边反馈、恒流模式 LED 功率开关，芯片工作在电感电流断续模式，同时芯片内部集成 650V 功率 MOSFET 和高压自供电电路，无需辅助绕组检测和供电，只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性，系统成本极低。

● HVDD 供电

DP830X 集成 650V 高压供电电路，功率 MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电，无需外置 VDD 电容。

● PSR 恒流控制

DP830X 系列工作在反激型原边控制恒流模式下，通过检测变压器退磁时间和 CS 脚上的电压信号，即可确定副边平均输出电流的大小。在 DP830X 中，变压器退磁时间 Tdem 和开关周期 Tsw 的比例固定在 1/2。因此，输出恒流值由以下公式决定：

$$I_{CC_OUT} (mA) = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_{cs(max)}}{R_{cs}} \cdot N_{ps} = \frac{150mV}{R_{cs} (\Omega)} \cdot N_{ps}$$

其中：

Rcs---连接于 CS 管脚和 GND 管脚之间的采样电阻。

Nps---变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。

● 电流采样和前沿消隐

在每次功率 MOSFET 导通的瞬间，都会在采样电阻两端产生由 MOSFET 寄生电容和续流二极管反向恢复电流造成的电压尖峰。为了避免驱动信号错误关断，芯片内部设计有前沿消隐时间。在此时间内（典型值 500ns），内部 PWM 比较器停止工作以保证驱动信号稳定导通。

● 消磁检测

DP830X 利用内部集成消磁检测电路，无需辅助绕组，极大减小了系统成本。

● 最长和最短关断时间

当功率 MOSFET 关断后，在 DP830X 内部设计有典型值 3us 的最短关断时间限制以避免干扰。同时，芯片内部典型的最长关断时间设计为 270us。

● 输出过压保护 (OVP)

DP830X 输出过压保护可通过 ROVP 管脚到地之间的电阻（ROVP）调节。芯片在 ROVP 管脚流出 IROVP=40uA 电流，该电流在 ROVP 电阻上产生一个电压 $V_{ROVP} = I_{ROVP} \cdot R_{OVP}$ ，同时芯片内部会采样 CS 端峰值电压 VCS_PK，VROVP 和 VCS_PK 共同作用并在每个周期产生一个过压保护时间 Tovp。当输出开路时，输出电压会升高，电感消磁时间 Tdem 会减小，当 Tdem 小于 Tovp 时，系统将触发输出 OVP 保护并进入自动重启状态，直至输出开路恢复时，系统才正常工作。

在关机过程或者输入电压很低时，系统会碰到最大导通时间，VCS_PK 和 Tovp 会等比例减小，这样能避免输出过压保护误触发。在隔离反激式电源系统中，原边电感消磁电压为输出电压和原副边匝比的乘积。因此，过压保护时消磁时间 Tdem 满足以下等式：

$$T_{dem} = T_{ovp} = \frac{L_p \cdot V_{CS_PK}}{N_{ps} \cdot V_{OVP} \cdot R_{cs}}$$

其中：

VCS_PK 为电流峰值采样电压，正常工作时为过流比较器参考电压（600mV）

VOVP 为过压保护电压值

当 Tdem < Tovp 时，系统将触发输出过压保护。而在系统设计时可以根据需要的过压保护电压（VOVP）来计算所需 ROVP 电阻阻值：

$$R_{OVP} \approx 0.07 \cdot \frac{N_{ps} \cdot V_{OVP} (V) \cdot R_{cs} (ohm)}{L_p (mH)} (kohm)$$

其中：

Lp 为变压器原边绕组感量

● 自动重启保护

当 LED 开路状态或者输出过压时，电路进入自动重启模式。此时内部功率 MOSFET 停止导通，同时内部计时器开始工作。当计时器计满 67ms 时，芯片将复位保护逻辑并进入重启模式。但是，如果重启后发现故障没有消失，则芯片将重复以上保护动作直至故障消失。

● **过热保护 (OTP)**

DP830X 内部集成有过热保护功能。当芯片检测到结温超过 145°C 时，内部的输出电流基准则开始逐渐降低直至达到温度平衡，如图 1 所示。通过过热保护功能，限制了系统的最高温度并提高了系统的可靠性。

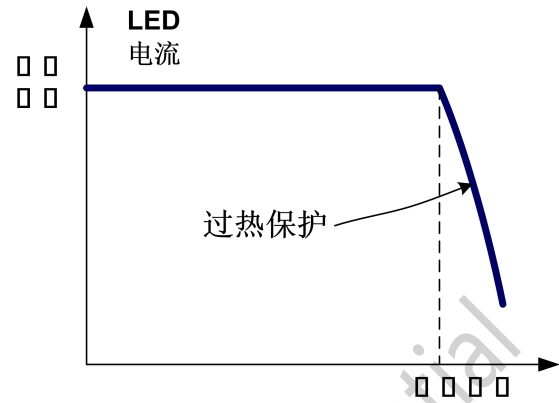


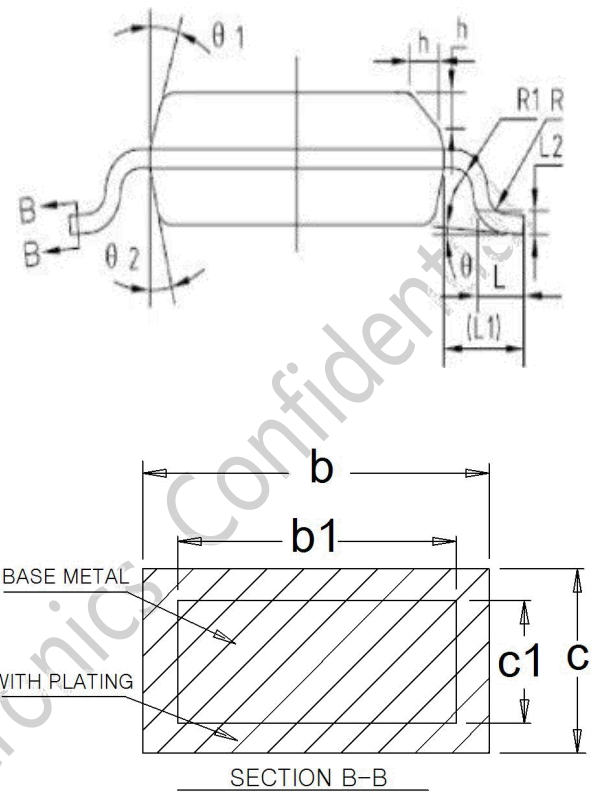
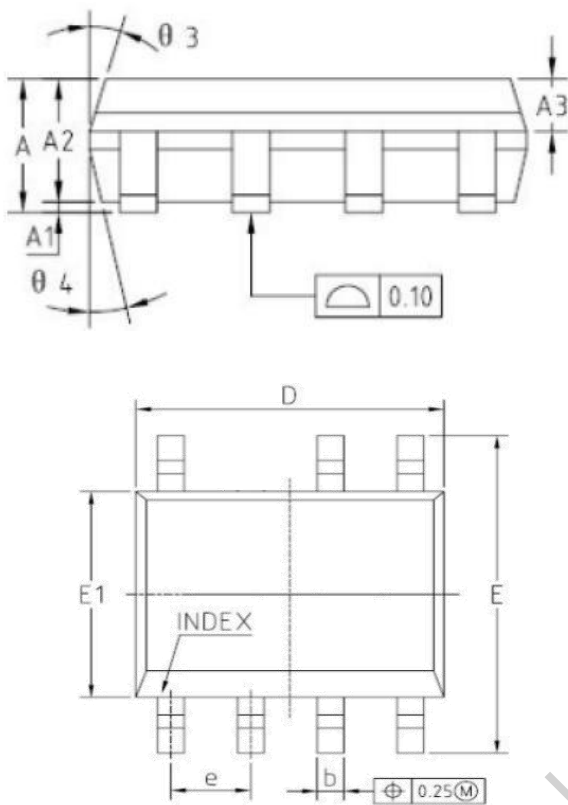
图 1

● **软驱动**

DP830X 设计有软驱动电路有效地降低了 EMI 噪声。

封装尺寸

SOP7

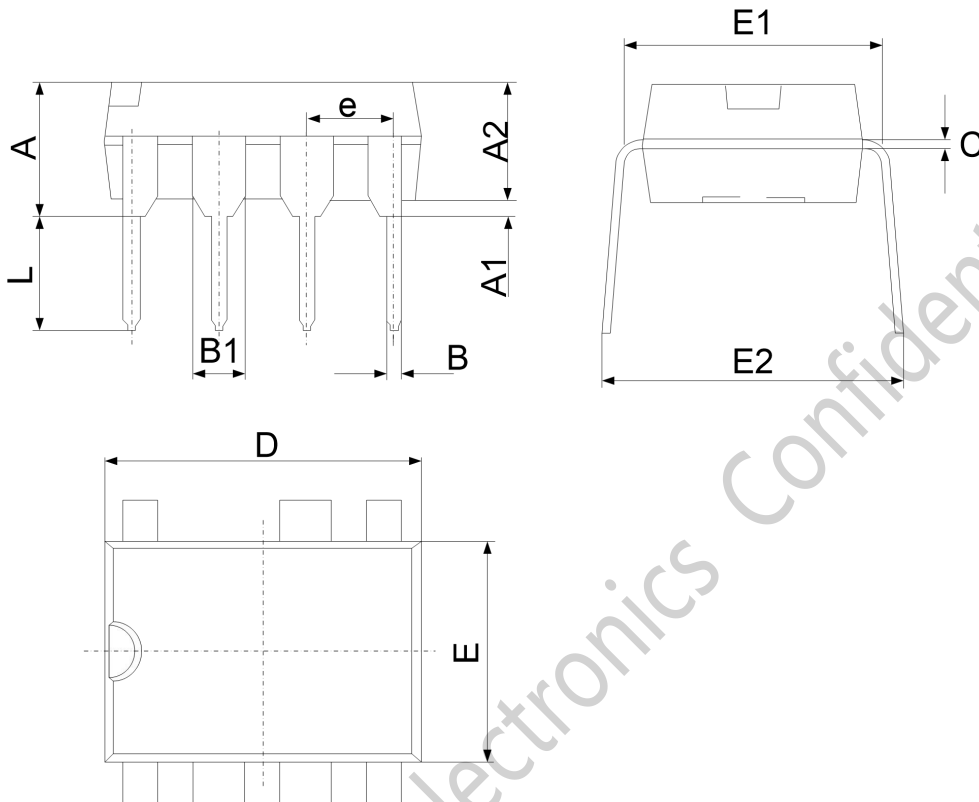


Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min	Nom	Max
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.10	0.15	0.20
A2	1.353	1.40	1.453
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.38	-	0.51
b1	0.37	0.42	0.47
c	0.17	-	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	4.85	4.90	4.95
E	5.85	6.00	6.15
E1	3.85	3.90	3.95
e	1.245	1.27	1.295
L	0.45	0.60	0.75
L1	-	1.050REF	-
L2	-	0.250BSC	-
θ1-θ4	12° REF		
h	0.40REF		
R	0.15° REF		
R1	0.15° REF		



封装尺寸

DIP-7



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(中心到中心)		0.060(中心到中心)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(中心到中心)		0.100(中心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

重要声明

德普微尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。客户在下单前应联系德普微获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的本公司销售条款与条件。

德普微会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

本产品规格书未包含任何针对德普微或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，德普微不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性，特定目的的适用性或者不侵犯德普微或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，德普微也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

德普微对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用本公司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

针对本规格书所披露的内容，在未获得德普微的授权下，任何第三方不得使用、复制、转换，一经发现本公司必依法追究其法律责任，并赔偿由此对本公司造成的一切损失。

请注意在本资料记载的条件范围内使用产品，特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害，本公司对此概不承担任何责任。

本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避免事故的发生。

使用本公司的 IC 生产产品时，如因其产品中对该 IC 的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本 IC 产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。